
האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

התקנים של מוליכים למחצה - 83812

תאריך עדכון אחרון 06-10-2021

נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פיסיקה יישומית

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' הרצל אהרוני

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: herzl@bgu.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום במייל

מורי הקורס:

פרופ הרצל אהרוני,
מר אריה גרוסמן

תאור כללי של הקורס:

קורס המשך ל- 83882.

התהליכים הפיסיקליים, מבנה ועקרונות הפעולה של התקני מוליכים למחצה הכוללים: טרנזיסטור
FinFET, טרנזיסטור MOS, קבל JFET,
טרנזיסטור BJT,
1. הרכב הציון- הציון הסופי יקבע ע"י ציון בחינת הסמסטר.

2. תרגילים - אין חובת הגשת תרגילים.

התרגילים ינתנו בכל נושא מספר הלימוד העיקרי של הקורס (יפורסמו ע"י המתרגל).

ספר הלימוד:

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

המחברים:

BEN G. STREETMAN

SANJAY KUMAR BANERJEE

הוצאת הספרים:

PRENTICE HALL

מהדורה שישית-2010

קורס זה-הוא קורס מקצועי וראוי להשקיע בו לא רק כמקור לידע אקדמי אלא כפוטנציאל לתעסוקה.
זאת מכיוון שהחומר הכלול בו נוכח בכל תחומי החיים כיום (דרך המחשבים, טלפונים ניידים, מיכשור
רפואי וכל ציוד אלקטרוני אחר כיום).

מטרות הקורס:

להבין התהליכים הפיסיקליים, מבנה ועקרונות הפעולה של התקני מוליכים למחצה

תוצרי למידה

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנת התהליכים הפיסיקליים, מבנה ועקרונות הפעולה של התקני מוליכים למחצה הכוללים:
טרנזיסטור JFET, קבל MOS, טרנזיסטור FinFET
טרנזיסטור BJT

דרישות נוכחות (%) :

אין

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

טרנזיסטור JFET, קבל MOS, טרנזיסטור FinFET
טרנזיסטור BJT

חומר חובה לקריאה:

ספר הלימוד:

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

המחברים:

BEN G. STREETMAN

SANJAY KUMAR BANERJEE

הוצאת הספרים:

PRENTICE HALL

מהדורה שישית-2010

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :

מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה 0 %

השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות: